Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0218U005167

Державний реєстраційний номер: 0117U004049

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-05-2018

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка конструкції фотодіодних структур на основі антимоніду індію.

Початок етапу: 12.2016

Закінчення етапу: 01.2017

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-40-20, 525-83-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Приватне підприємство "Науково-дослідний центр радіоелектроніки "Полюс""

Код за ЄДРПОУ: 13314929

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Публічне акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро Ритм"

Код за ЄДРПОУ: 14261388

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Державний комітет промислової політики України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 8(03722) 42-26-13

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 490

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технологічних процесів виготовлення фотодіодних структур антимоніду індію

Назва роботи англійською:

Development of thecnological processes and manufacturing of InSb photodiod structures

Реферат українською:

Розроблено технологічні схеми виготовлення інфрачервого фотоприймального пристрою на основі антимоніду індію з гранично можливими пороговими параметрами.

Реферат англійською:

Technological schemes of manufacturing of infrared photodetector device on the basis of indium antimonide with the maximum possible threshold parameters are developed.

Індекс УДК: 537.311.322, 537.311.322

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кладько Василь Петрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Бєляєв Олександр Євгенович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Перелік осіб-виконавців

Романюк Борис Миколайович

Сапон Сергій Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

